









	<b>HGTG11N120CN</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	HGTG11N120CN
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT 1200V 43A 298W TO247
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">HGTG11N120CN.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5428 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	HGTG11N120CN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1200V 43A 298W TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-IGBTs</a>
Teilstatus	5428 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 1200V 43A 298W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	298W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Strom - Kollektor (Ic) (max)	43A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 11A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	80A
Schaltenergie	400µJ (on), 1.3mJ (off)
Gate-Ladung	100nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/180ns
Testbedingung	960V, 11A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


HGTG11N120CN ist neu im Original, Suche HGTG11N120CN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG11N120CN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG11N120CN: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HGTG10N120BND</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG11N120CND</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTG12N60A4</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p><b>HGTG10N120BND</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO247</p>
 <p><b>HGTG12N60A4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p><b>HGTG11N120CN</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p><b>HGTD8P50G1</b> HARRIS HARRIS TO-251</p>	 <p><b>HGTG10N120BN</b> Fairchild/ON Semiconductor HGTG10N120BN FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

 HGT1S20N60A4S9A	 HGT1S20N60A4S9A	 HGT1S20N60C3R	 HGT1S20N60C3RS	 HGT1S2N120CN
 HGT1S2N120CN	 HGT1S3N60A4DS	 HGT1S3N60A4DS9A	 HGT1S3N60A4DS9A	 HGT1S3N60B3DS
 HGT1S3N60C3DS9A	 HGT1S7N60A4DS	 HGT1S7N60A4DS	 HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D	 HGT1S7N60A4DS9A
 HGT1S7N60A4S9A	 HGT1S7N60B3	 HGT1S7N60B3DS	 HGT1S7N60B3S	 HGT1S7N60C3DS9A
 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1N120BNS9A	 HGT1N120BNS9A	 HGT1N120BND	 HGT1N120BND
 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CND	 HGTG11N120CND	 HGTG12N60A4	 HGTG12N60A4
 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60B3D	 HGTG12N60C3D	 HGTG12N60C3D
 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BND	 HGTG18N120BND	 HGTG20N120CND
 HGTG20N120E2	 HGTG20N50C1D	 HGTG20N60	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4
 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited